

GaAs pHEMT MMIC 4 位数控移相器, 1 - 2 GHz

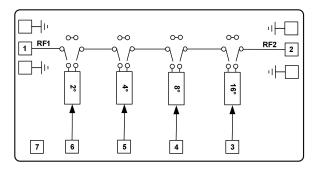
主要特点

移相范围: 30° 最小移相量: 2° 移相精度 RMS: 1.5° 插入损耗: 1.8 dB 移相幅度调制: ±0.3 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: 2.5 × 1.2 × 0.1 mm³

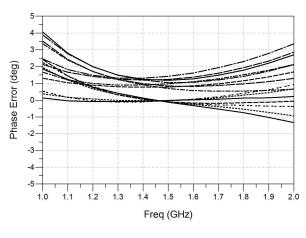
功能框图



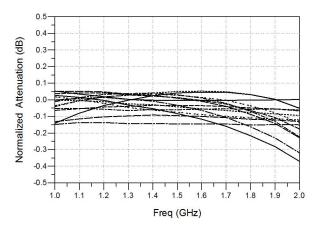
性能指标 (T_A = +25°C, VCTL = 0/5 V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	1 - 2		GHz	
插入损耗		1.8		dB
移相精度 RMS		1.5		0
移相幅度调制		±0.3		dB
回波损耗		15		dB
输入功率 1dB 压缩点		24		dBm
切换时间		30		ns

全态移相精度



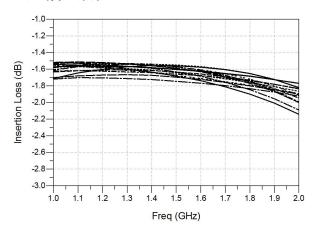
全态幅度调制



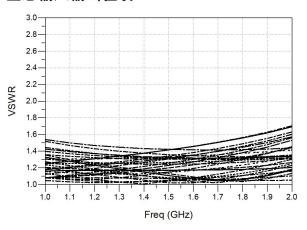


GaAs pHEMT MMIC 4 位数控移相器, 1 - 2 GHz

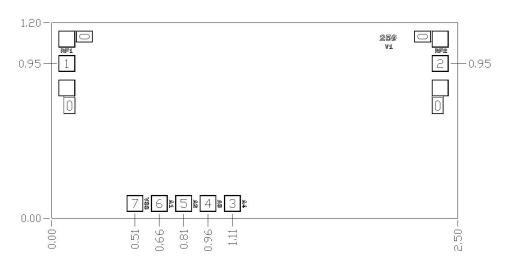
全态插入损耗



全态输入输出驻波



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1,RF2	该焊盘是射频端口,DC 耦合并匹配至 50 Ohm,如果 RF 电位不是 0V,那么需要外部加入隔直电容
3	A4	A4=0V 时 16°移相器关闭,A4=+5V 时 16°移相器打开
4	A3	A3=0V 时 8°移相器关闭,A3=+5V 时 8°移相器打开
5	A2	A2=0V 时 4°移相器关闭,A2=+5V 时 4°移相器打开
6	A1	A1=0V 时 2°移相器关闭,A1=+5V 时 2°移相器打开
7	VSS	该焊盘是数字电路电源端口,接-5V 电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

5

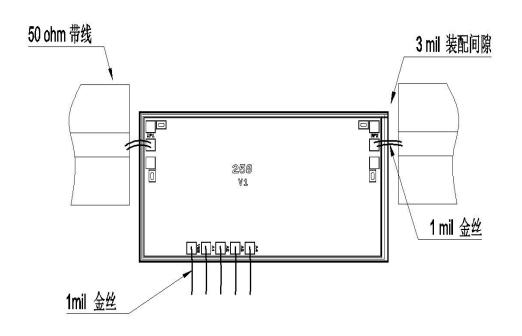


GaAs pHEMT MMIC 4 位数控移相器, 1 - 2 GHz

真值表

状态	2°	4°	8°	16°		
	P1	P2	P3	P4		
参考态	0	0	0	0		
2°	1	0	0	0		
4°	0	1	0	0		
8°	0	0	1	0		
16°	0	0	0	1		
"0" 电平范围: 0~0.5V; "1" 电平范围: 3~5V						

推荐装配图



注意事项

- 1. 芯片厚度为 100 um
- 2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 um²
- 3. 键合焊盘金属化: 金
- 4. 芯片背面镀金
- 5. 芯片背面接地
- 6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

- 1. 射频输入功率: +24 dBm
- 2. 储存温度: -65~+150°C
- 3. 工作温度: -55~+85°C